THOA02 2021/8/12 10:30-10:50

SAGA-LS電子蓄積リングにおける ビームロス発生時のビームプロファイル観測 Observation of the beam profile at the moment of beam loss in the SAGA-LS storage ring

第18回日本加速器学会

SAGA-LS 岩崎能尊

Outline

• Introduction ランプアップ時のビームロス ーどのような問題に取り組むのか?-

- Method
 PXIによる観測システムの拡張
- Result

ビームプロファイル形状の変化と 他のパラメーターの同時観測結果

- Summery
- Future plan





加速直後に発生する不連続なビームロス



加速直後に10mAロスしたケース

・タウシェック寿命、真空寿命、量子寿命では 説明できない

- ・ある蓄積ビーム電流以上で発生(I>200mA)
- ・加速直後に発生する(E<0.4 GeV)
- ・ビームロス量にはバラつきがある(△l~10mA) 全ロスする場合もある



ランプアップ時ビームロスの統計

2018年11月15日から2019年7月12日にかけてのユーザー運転(320mAランプアップ)



ランプアップ開始直後のビームロス要因の特定と対策

目的:

・ビームロスの要因を特定し、対策することで更なる加速器運転の安定化を目指す。

・ランプアップに要する時間を縮小し、加速器運転のパフォーマンスを向上する。

方法: PXIを用いた速い計測系の整備により、ビームロスの要因を特定し対策を行う。 ビーム位置、電磁石電源、ビーム電流およびビームプロファイルの同時観測を行う。



ビームプロファイルモニタ:BL21光源用観測ポートCCD

方法:ビームロスのメカニズムを解明するため、PXIシステムにてビームプロファイルを観測 ビームポジションモニタ (BPM) ではビームの重心位置情報しかわからない 入射不調時の要因解明にも使える



- ・蓄積リング室内→電源室CCDカメラビデオ信号ケーブルの敷設
 蓄積リング室内で既存ケーブルより分岐
 電源室BNC取り合いポートより電源室PXI置き場まで延長
- ・電源室→制御室 専用LANケーブルの敷設 既存の制御LANの負荷にならないように、専用線を新設(ノイズシールドタイプ)
- アナログ・デジタル変換モジュール(ACLD400)用カメラファイル作成(N.I.協力)
 <u>PXIe-1435</u>(Frame Grabber)にCameraLink信号を取り込むためのカメラファイル

 ・ビーム電流、偏向電磁石電源、その他リング主要電源出力のPXIへの取り込み PXIe-4300, 16bit, 8ch, 250 kS/s 1kHzローパスフィルタ付きADC 他の物理量とビームプロファイルの同時観測。

・ノイズ対策

ノイズにより計測が途中で停止。PXI(LabVIEW RT)で稼働させているため、VIのエラークリアでは単純に対処できない。

ノイズは電源室内のビデオ信号部に発生していることが判明。→インラインノイズフィルター によりカット



・画像収録アプリケーション製作

ビームプロファイルのデジタル常時表示および記録が可能となった。画像のサンプリングそのものは60Hz以上で可能(入力ソースに依存)。

ビームプロファイル画像はビーム電流、偏向電磁石電源出力と同時に計測可能。記録した画像のファイル名に自動的にタイムスタンプ、ビーム電流および偏向電磁石 出力を記録。



画像処理(LabVIEW)

・ビットマップ画像を数値データーに変換

・ノイズ除去

・強度の等高線処理

3D表示

 数值処理 ビームサイズ、重心位置、 最大・最小値など ただし、絶対値の評価は難しい

数値処理(ガウシアンフィットなど)





0.00-

0.00

22.80

45.60

Y Axis

68.40

91.20

114.00

元画像

ログ経過時間『(秒) 0.50 nergy (GeV) 0.2560

urrent (mA) 310.49

結果:

ランプアップ開始直後のビームロス(2021/2/8 4-20mAロス)



ランプアップ開始直後のビームロス(2021/2/8 20mAロス)



ランプアップ開始直後にビームロスが発生しないケース(2021/3/30)



ランプアップ開始直後(E~入射エネルギー)にビームロスが発生しない 場合、特に大きな垂直方向ビーム形状の増大は見られない。

ランプアップ開始しばらくしてのビームロス (2021/3/1 50mAロス E~360 MeV)



ランプアップ開始しばらくしてのビームロス (2021/3/1 50mAロス E~360 MeV)





ビームロス時、垂直方向ビーム形状の広がりが明らかに確認される。

瞬間的ビームロス (2021/3/30 全ロス E~490 MeV)







瞬間的ビームロス(2021/3/30全ロス E~477 MeV)





0.1~0.2秒程度の間にビーム全ロス。 ビームロスする間のデータが十分に取得できていない。 画像のサンプリング速度はこの時は10Hz. 更に早いサンプリング速度が必要。

相関が不明瞭(2021/2/162段階ビーム20mAロス E~340 MeV)





ビーム広がりが最大になる時間とビームロスの時間が完全に一致 しない。 始めのロス時に特に大きなビーム形状の変化が見られない。 想定されるビームロス要因

ある境界以上に垂直方向ビームが広がったときにビームロスが発生するように見える。

⇒<u>アクセプタンスを超えた電子が損失する。</u>

ビーム形状がオペレーション毎に変化する要因

- ・チューン $\Rightarrow 4$ 極電源出力の再現性に問題あり?
- ・ $<u>クロマティシティー</u> <math>\Rightarrow$ 6極電源出力波形に問題あり?
- ・カップリング \Rightarrow 入射時から $E \sim 300 MeV$ 程度までskew4極の出力なし \rightarrow 要因でない
- ・ビーム位置 \Rightarrow 入射時から $E \sim 300 MeV$ 程度までST一定値 \rightarrow 要因でない

その他の想定される要因

- ・真空度(イオントラッピング、クリアリング電極電圧)
- ・インピーダンス
- ・その他ビーム不安定性

⇒可能な限り電源出力を滑らかにランプアップを行う。 まずはダイナミックな影響が無視できる状態でのテストを実施。

ダイナミックな影響を排したランプアップテスト

353-リモートのPCにあるLabVIEWプログラムから、 352 Beam Current (mA) 1Hzにて338 MeVまでのランプアップパターン出 力(通常はPLC内に保存したパターンを出力)。 351 ・4極電磁石電源(チューン固定)励磁 350-・6極エネルギーに対しリニア励磁 349 ランプアップ開始から、338 MeVに達するまでに 要した時間は約506秒(8分26秒)。 348-0.28 0.3 0.32 0.26 0.34 Energy (GeV) 0(s)506 (s)

ダイナミックな影響が無視できる状況においては、チューン、クロマティシティーが固定さ れていれば、ランプアップ直後の不連続なビームロスは発生しない。

入射点における4極および6極の安定領域



・4極はI・τが急落する縁に入射点がある

・6極の安定領域は4極に比較して広い
 入射エネルギー付近で4極: ±0.1A以下、

- 4極安定領域: ΔI/I~2×10⁻³ 6極安定領域: ΔI/I~8×10⁻²
- 6極: ±0.5A以下の精度で制御しないとビームロスの要因となる。
- ・ランプアップの際に発生する渦電流の効果は無視できない。

渦電流の効果

長方形の真空チャンバーに誘起される渦電流

$$\partial^2 B_y / \partial x^2 = 2\mu_0 \sigma_c \frac{h}{g} \frac{dB_y}{dt}$$

μ₀:真空透磁率

σ_c: 導電率

h:厚み

g: ギャップ

SAGA-LS偏向電磁石真空チャンバーの典型的な寸法、1分でランプアップする場合、6極成 分としておおよそ

K~0.123 程度の渦電流の影響がある。

偏向電磁石チャンバーにこの6極成分が発生した場合、クロマティシティーの変化は $\Delta \xi_x \sim 0.067, \Delta \xi_y \sim 0.512$ これを補正するための6極強さは、 $\Delta K_{SF} \sim 0.028, \Delta K_{SD} \sim 0.353$ 入射時の6極電磁石の強さの比としては $\Delta K_{SF}/K_{SF} \sim 0.003, \Delta K_{SD}/K_{SD} \sim 0.032$

⇒6極の安定領域に影響を与える可能性がある

(入射エネルギーでの6極電磁石の安定領域∆I/I ~8×10⁻²)

ランプアップ直後の電源出力の測定



*グラフの時間は実時間の10倍

SF電源にランプアップ直後のジャンプ(出力の跳ね)、QFW1, QDW1電源にはQF1およびQD1電源と比較 して出力の大きな乱れが見られる。しかし、明確なビームロスとの相関は見られない。

ランプアップパターン調整



Time (s) *QF2電源の出力は電子ビームエネルギーに比例。グラフの垂直方向はエネルギーの指標。

・コミッショニング期に試行錯誤で決定したランプアップパターンにおいてはチューンおよび
 クロマティシティーが保存されていなかった。

・マシンスタディーにより、チューンおよびクロマティシティーが固定されるようにランプ
 アップパターンを調整。

・1.4 GeV到達までの所要時間を短縮。

・しかし、20 mA程度のランプアップ直後のビームロスの発生は完全には抑制できなかった。

ランプアップパターン微調整 ランプアップ開始時電源出力の安定化



*QF2電源の出力は電子ビームエネルギーに比例。グラフの垂直方向はエネルギーの指標。

ランプアップ開始時のリング主要電源の出力増加をビームロスが発生しない程度に低速化。 エネルギーが高い領域では可能な限り高速化。1.4 GeV付近は熱負荷および空洞パワーの増加 を考慮して低速化。

⇒E<0.4 GeV以下での不連続なビームロスはほぼ解決された。

まとめ

- ランプアップ開始直後(E<0.4 GeV)に発生するビームロス要因を特定するために、PXI システムによるビームプロファイルとビーム位置、電磁石電源、ビーム電流の同時観測 システムを構築した。
- ビームロス時に垂直方向ビームサイズ増大が見られた。
- 入射エネルギーにおける安定領域は狭く、その領域内に収まるように滑らかなランプ アップパターンを構築。
- ビームロスはほぼ解消された。
- 1.4 GeV到達までの時間を4分半から1分半に短縮した。
- PXIシステムによる画像とデーターの同時高速観測システムは有用。他の事例にも応用できる。

今後の予定

- 必ずしも垂直方向ビームサイズとビームロスの関係が明確ではないケースがある。
- 長手方向の運動観測

(シンクロトロン振動、バンチ長など)

- ビームロスのひとつの要因は垂直方向の空間的なアクセプタンス を超えた電子の損失と考えられる。
- 入射時における安定領域が狭い理由はビームのブローアップであろう。
- 入射時におけるビームのブローアップを抑制することで、現在最大で400 mA程度の蓄積ビーム電流を増加させることが可能かもしれない。

ご視聴ありがとうございました。